

溶剂热氧化少层 Ti_3C_2 MXene 制备二维 $\text{TiO}_2/\text{Ti}_3\text{C}_2$ 复合光催化剂

严康^{1,2} 关云峰¹ 丛野^{*,1,2} 徐佃祥¹ 朱辉^{1,2} 李轩科^{*,1,2}

(¹ 武汉科技大学, 湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室, 武汉 430081)

(² 武汉科技大学, 省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室, 武汉 430081)

摘要: 为了改善 TiO_2 光催化剂光生电子-空穴对复合率高、太阳光利用率低的缺陷, 采用溶剂热法控制氧化剥离的少层 Ti_3C_2 MXene(DL- Ti_3C_2), 制备 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 复合光催化剂, 并通过降解罗丹明 B 溶液, 研究其光催化性能。结果表明, $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 复合光催化剂能有效吸收可见光, 且光催化性能明显优于 DL- Ti_3C_2 和 P25。当溶剂热氧化温度为 160 ℃时, 复合材料具有最佳的光催化性能。当氧化温度过低时, 催化剂中形成的 TiO_2 量不足, 产生的光生电子-空穴对数量较少, 导致催化剂性能较差; 当氧化温度过高时, DL- Ti_3C_2 减少, 降低了材料导电性, 光生电子-空穴对复合效率高, 导致催化剂性能变差。因此, 通过改变 DL- Ti_3C_2 的氧化温度, 可以调控 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 复合材料中 TiO_2 和 DL- Ti_3C_2 的相对含量, 使二者产生协同作用提高复合光催化剂的可见光催化活性。

关键词: $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$; 溶剂热法; 光催化; 复合材料; 协同作用

中图分类号: TQ426.6 文献标识码: A 文章编号: 1001-4861(2019)07-1203-09

DOI: 10.11862/CJIC.2019.142

Preparation of Two Dimensional $\text{TiO}_2/\text{Ti}_3\text{C}_2$ Photocatalyst by Solvothermal Oxidation of Few-Layered Ti_3C_2 MXene

YAN Kang^{1,2} GUAN Yun-Feng¹ CONG Ye^{*,1,2} XU Tian-Xiang¹ ZHU Hui^{1,2} LI Xuan-Ke^{*,1,2}

(¹Hubei Province Key Laboratory of Coal Conversion & New Carbon Materials,

Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China)

(²State Key Laboratory of Refractories and Metallurgy, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China)

Abstract: In order to solve the defects of TiO_2 photocatalyst, including the rapid recombination of photo-generated electronhole pairs and low solar light utilization, two dimensional $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ composite photocatalysts were prepared using solvothermal method to control the oxidation of delaminated Ti_3C_2 MXene with few layers (DL- Ti_3C_2)。The photocatalytic performance of $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ composite was evaluated by degrading rhodamine B solution。The results show that $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ photocatalyst exhibited strong absorption for visible light and better photocatalytic performance than pure DL- Ti_3C_2 and P25。The $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ composite oxidized at 160 ℃ in solvothermal process obtained the best photocatalytic performance。When the oxidation temperature was too low, the amount of TiO_2 formed in the composite was insufficient to produce enough photo-generated electron-holes pairs, resulting in the unsatisfied performance of the photocatalyst。On the contrary, when the oxidation temperature was exceedingly high, the residual DL- Ti_3C_2 was unable to keep its outstanding conductivity, which accelerated the fast recombination of photo-generated electron-hole pairs and made the performance poor。Consequently, the relative contents of TiO_2 and DL- Ti_3C_2 in $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ composites could be effectively regulated by varying the oxidation temperature of DL- Ti_3C_2 , so as to improve the photocatalytic activity due to the synergistic effects of TiO_2 and DL- Ti_3C_2 。

Keywords: $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$; solvothermal method; photocatalytic; composite material; synergistic effect

收稿日期: 2019-02-16。收修改稿日期: 2019-04-25。

国家自然科学基金(No.51472186, 51402221)资助项目。

*通信联系人。E-mail: congye626@126.com, xkli8524@sina.com

0 引言

TiO_2 具有氧化效率高、无毒、光稳定性好、成本低以及绿色环保等优点^[1-2], 是一种很有应用前景的半导体光催化剂。但是光生电子-空穴对复合效率高降低了 TiO_2 的光催化性能^[3-4], 成为 TiO_2 光催化剂最主要的缺陷; 其次, TiO_2 的禁带较宽, 在紫外光照射下才能激发产生电子-空穴对, 对太阳光的利用率低^[5-6], 使得 TiO_2 难以被大规模应用于光催化领域。为了提高 TiO_2 的光催化性能, 研究人员对 TiO_2 光催化剂进行了改性处理, 其中包括贵金属沉积^[7]、阳离子掺杂改性^[8]、阴离子掺杂改性^[9]、半导体复合改性^[10]等。已有大量文献报道证实用 RGO(还原氧化石墨烯)或 GO(氧化石墨烯)修饰 TiO_2 可以提高 TiO_2 的光催化性能。Fan 等^[11]通过几种不同的方法合成了 RGO/ TiO_2 复合材料, 形成的 C-O-Ti 键使得 TiO_2 的带隙变窄, 而 RGO 优异的导电性降低了 TiO_2 光生电子-空穴对的复合率, 光催化性能得到明显提升。龙梅等^[12]利用水热法制备了 RGO- TiO_2 复合光催化剂, 相比于纯的 TiO_2 而言, RGO- TiO_2 复合光催化剂禁带宽度变窄且电子空穴对复合率降低, 具有更高的光催化活性。

$\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ MXene 是一种新型的二维纳米材料, T_x 代表表面的负载基团(如羟基、氧或氟)^[13], 可以由氢氟酸^[13]或盐酸和氟化锂的混合液^[14]处理 Ti_3AlC_2 前驱体得到。通过氢氟酸处理 Ti_3AlC_2 前驱体得到的 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ MXene 具有典型的手风琴结构, 由多层的 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 堆叠而成, 标记为 ML- Ti_3C_2 (multilayer Ti_3C_2 MXene); 通过盐酸和氟化锂混合液处理 Ti_3AlC_2 前驱体并经过超声插层处理得到的 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 由一层或几层 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 组成^[15-16], 标记为 DL- Ti_3C_2 。DL- Ti_3C_2 具有独特的类石墨烯二维结构、优良的导电性、高的比表面积、亲水性表面以及丰富的表面含氧基团等优点^[17-18], 是一种高效的半导体光催化剂的助催化剂。Zhang 等^[19]利用二氧化碳作为氧化剂在 500 ℃氧化 ML- Ti_3C_2 , 在 ML- Ti_3C_2 的层间和边缘形成了大量的 TiO_2 纳米颗粒。相比于 ML- Ti_3C_2 , TiO_2 /ML- Ti_3C_2 复合材料电极的比容量更高, 循环稳定性更好。Lotfi 等^[20]研究了 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 在不同环境(干燥空气、湿润空气和过氧化氢溶液)及不同温度(1 000~3 000 K)下的氧化情况, 发现不同环境中 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 的氧化速率不一样, 而且可以通过控制反应温度得到不同含量、晶型的 TiO_2 与 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 的复合材料。Naguib 等^[21]利用水热法

在不同条件下(150 ℃反应 48 h; 200 ℃反应 8、12 和 20 h; 250 ℃反应 2 h) 氧化 ML- Ti_3C_2 制备 TiO_2 /ML- Ti_3C_2 复合材料, 与 CO_2 氧化 ML- Ti_3C_2 制备的 TiO_2 /ML- Ti_3C_2 复合材料相比, TiO_2 在 ML- Ti_3C_2 片层上分布更均匀。溶剂热法具有产物分散性较好、粒径大小和形态容易控制等优点。

因此, 本文采用溶剂热法, 用乙醇作为反应溶剂, 通过控制氧化 DL- Ti_3C_2 一步合成 TiO_2 /DL- Ti_3C_2 复合光催化剂, 并考察不同氧化温度对 TiO_2 /DL- Ti_3C_2 复合光催化剂的结构和性能的影响。控制氧化 DL- Ti_3C_2 可以一步合成 TiO_2 /DL- Ti_3C_2 复合材料, TiO_2 光照下能够产生电子-空穴对, 而 DL- Ti_3C_2 能够提供电子传输通道以提高电子空穴分离效率, 同时 TiO_2 和 DL- Ti_3C_2 之间形成的 C-O-Ti 等化学键能够有效减小 TiO_2 的禁带宽度, 以期提高其光催化性能。

1 实验部分

1.1 实验试剂

实验所用的 Ti 粉(300 目, 纯度为 99.99%)和 Al 粉(300 目, 纯度为 99.5%)购于北京中金研新材料科技有限公司; 天然石墨(400 目, 纯度为 99.9%)购于青岛金海石墨制品有限公司; LiF(纯度为 99.9%)购于阿拉丁化学试剂有限公司; 二氧化钛 P25(纯度为 99.5%)购于 Degussa 中国有限公司; 实验所用的其它化学试剂均为分析纯, 购于国药集团化学试剂有限公司。

1.2 DL- Ti_3C_2 的制备

将 Ti 粉、Al 粉和天然石墨按照物质的量之比 3:1.2:2 球磨混匀, 然后于管式电阻炉中在 Ar 气氛下 1 350 ℃($10^\circ\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$) 保温 30 min 合成 Ti_3AlC_2 前驱体。将 5 mL 蒸馏水与 15 mL 盐酸(36.5%(*w/w*))混合均匀。称取 1.0 g LiF 粉末加入到上述稀释的盐酸中, 磁力搅拌 30 min 使其充分溶解。然后将 1 g Ti_3AlC_2 粉末分次缓慢加入上述混合溶液中, 最后于 30 ℃搅拌 24 h 进行刻蚀。之后对样品进行多次离心分离和蒸馏水洗涤, 直到 pH 值达到 6 左右; 然后向清洗过后的样品中加入 20 mL 蒸馏水超声 30 min, 离心($3\ 000\ \text{r}\cdot\text{min}^{-1}$)得到 DL- Ti_3C_2 的悬浮液。

1.3 TiO_2 /DL- Ti_3C_2 复合材料的制备

量取一定体积的悬浮液进行抽滤, 通过抽滤前后滤膜的质量变化计算悬浮液中 DL- Ti_3C_2 的浓度。将 DL- Ti_3C_2 悬浮液和无水乙醇按照体积比 1:1 加入水热反应釜中, 在不同温度下(120、140、160 和 180

℃)反应 24 h, 制备 TiO₂/DL-Ti₃C₂ 复合光催化剂, 并将其标记为 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T, 其中 T 表示溶剂热反应温度。

1.4 材料表征

实验采用 Bruker A X'Pert PRO MPD 型转靶 X 射线粉末衍射仪对材料进行 X 射线衍射(XRD)测试, 测试电压为 40 kV, 电流为 30 mA, 并以波长为 0.154 056 nm 的 Cu K α 辐射线为辐射源, 扫描范围为 5°~90°。样品的微观形貌和显微结构由场发射扫描电子显微镜(NOVA 400 NANOSEM, 工作电压 30 kV)和场发射透射电子显微镜(FEI Tecnai G2 F20 STWIN, 加速电压 120 kV)进行表征。采用激光拉曼光谱仪(LabRam HR Evolution)对材料进行拉曼光谱(Raman)测试。材料的元素组成、元素含量和化学键等信息通过 X 射线光电子能谱(XPS)进行分析, 测试仪器为 ThermoFischer ESCALAB 250Xi。材料的比表面积通过 ASAP 2020 物理吸附仪测试得到。采用紫外可见分光光度计(日本岛津公司 UV-2550PC)测试材料的紫外-可见漫反射光谱, 以 BaSO₄ 标准空白样作参比, 扫描波长范围为 300~800 nm。采用荧光光谱分析光催化剂的电子和空穴分离效率, 测试仪器为日立 F-7000 荧光分光光度计。

1.5 光催化性能测试

将 0.05 g 光催化剂加入到 100 mL 浓度为 50 mg·L⁻¹ 的罗丹明 B 溶液, 之后将搅拌的悬浊液置于黑暗环境中吸附 2 h, 直至吸附/脱附平衡, 然后在可见光下进行光催化降解。实验利用中教金源 CEL-HXF300 型氙灯光源模拟太阳光, 并配备滤波片, 将得到的波长大于 420 nm 的可见光用于光催化降解实验, 利用 X3PC UV-Vis 分光光度计测定溶液的吸光度以确定其降解率。

2 结果与讨论

2.1 样品的物相与形貌分析

图 1 为所制备的 Ti₃AlC₂ 前驱体及 DL-Ti₃C₂ 的 XRD 图。图 1(a)在 2θ=9.5°、34.0°、39.0°、41.8° 和 60.8° 处的衍射峰分别对应 Ti₃AlC₂ (PDF No.00-052-0875) 的(002)、(101)、(104)、(105) 和 (110) 晶面, 说明产物中主要存在 Ti₃AlC₂, 且结晶度较高; 在 2θ=35.9° 和 72.4° 处的弱的衍射峰对应 TiC(PDF No.00-031-1400) 的(111) 和 (311) 晶面, 说明合成的 Ti₃AlC₂ 前驱体中存在少量的 TiC 杂质。Ti₃AlC₂ 在盐酸和氟化锂混合液刻蚀处理之后(图 1(b)), Ti₃AlC₂ 的衍射峰消失, 在

2θ=6.4°、17.8°、28.2°、35.6°、43.0° 和 60.8° 处出现了新的衍射峰, 分别对应 Ti₃C₂T_x 的(002)、(006)、(008)、(0010)、(0012) 和 (110) 晶面, 说明 Ti₃AlC₂ 在刻蚀之后形成了 Ti₃C₂T_x, 而且与文献报道的 ML-Ti₃C₂ 相比, (002) 晶面的特征衍射峰向低角度移动, 说明制备的 Ti₃C₂T_x 层间距比 ML-Ti₃C₂ 更大。

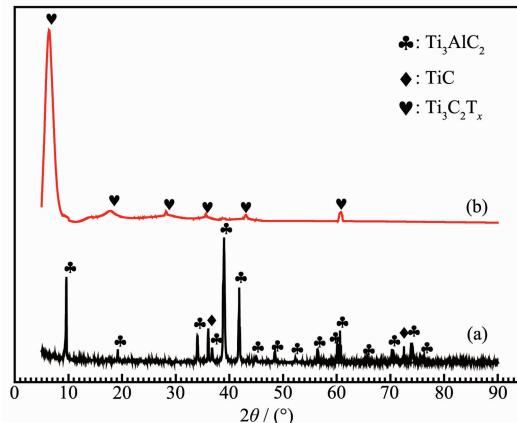


图 1 (a) Ti₃AlC₂ 和(b) DL-Ti₃C₂ 的 XRD 图
Fig.1 XRD patterns of (a) Ti₃AlC₂ and (b) DL-Ti₃C₂

为了进一步证明实验成功制得了 DL-Ti₃C₂, 对 Ti₃AlC₂ 刻蚀处理前后的微观形貌进行了 SEM 表征。图 2 为 Ti₃AlC₂ 在盐酸和氟化锂的混合液处理前后的 SEM 图。从图 2(a)中可以看出, 合成的 Ti₃AlC₂ 具有 MAX 相典型的三元层状结构且表面光滑。Ti₃AlC₂ 在用混合液处理后(图 2(b)), 形貌发生了明显的变化, Ti₃AlC₂ 的三元层状结构被剥离开, 形成了一层或几层堆叠的卷曲片层, 与文献^[22]报道的 DL-Ti₃C₂ 形貌一致。盐酸和氟化锂混合液能够成功剥离 Ti₃AlC₂ 制得 DL-Ti₃C₂ 是因为 Ti₃AlC₂ 前驱体中 Ti-C 键主要是共价键和离子键, 强度高; 而 Ti-Al 和 Al-Al 键有较多的金属键成分, 相对较弱, 所以 Ti₃AlC₂ 在用盐酸和氟化锂混合液处理之后能够剥离掉 Al 元素, 后期经过超声处理将水分子插入 ML-Ti₃C₂ 的层间可进一步扩大其层间距得到 DL-Ti₃C₂。

为了表征 DL-Ti₃C₂ 氧化后的物相组成, 对 DL-Ti₃C₂ 在不同温度溶剂热氧化后的产物进行了 XRD 分析。图 3 为不同温度氧化后的 TiO₂/DL-Ti₃C₂ 的 XRD 图。位于 2θ=25.3°、36.9°、37.8°、48.0°、53.9°、55.1°、62.8°、68.8°、75.1° 和 82.7° 处的衍射峰分别对应锐钛矿型 TiO₂ (PDF No.01-084-1286) 的(101)、(103)、(004)、(200)、(105)、(211)、(204)、(116)、(215) 和 (224) 晶面; 位于 2θ=6.3° 和 60.8° 处的衍射峰分别对应 Ti₃C₂T_x 的(002) 和 (110) 晶面。当氧化温度较低时,

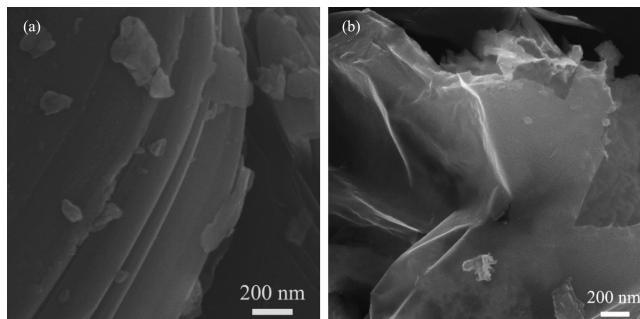
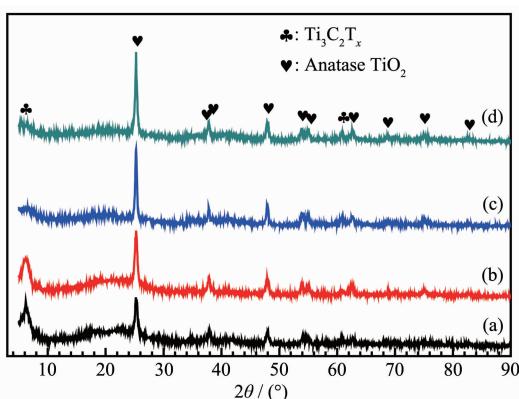
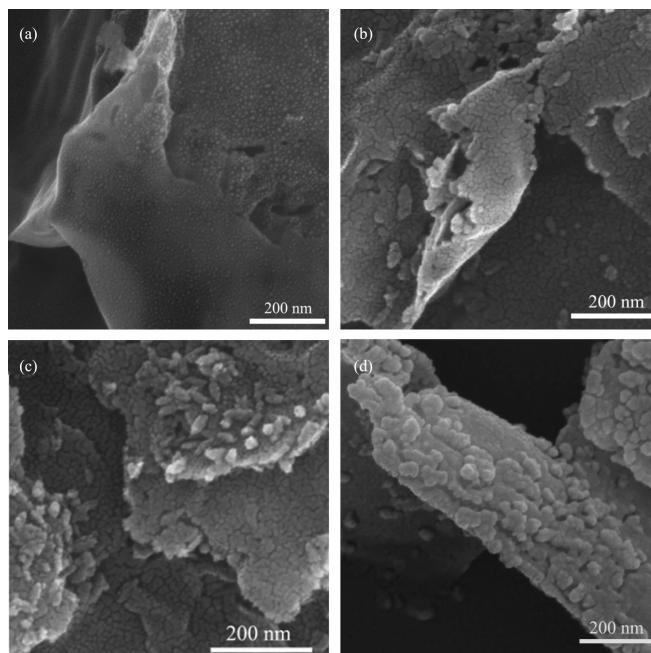


图2 (a) Ti_3AlC_2 和(b) $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的 SEM 图
Fig.2 SEM images of (a) Ti_3AlC_2 and (b) $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$



(a) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}120$, (b) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}140$, (c) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}160$ and (d) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}180$

图3 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}T$ 的 XRD 图
Fig.3 XRD patterns of $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}T$



(a) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}120$, (b) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}140$, (c) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}160$ and (d) $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}180$

图4 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}T$ 的 SEM 图
Fig.4 SEM images of $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}T$

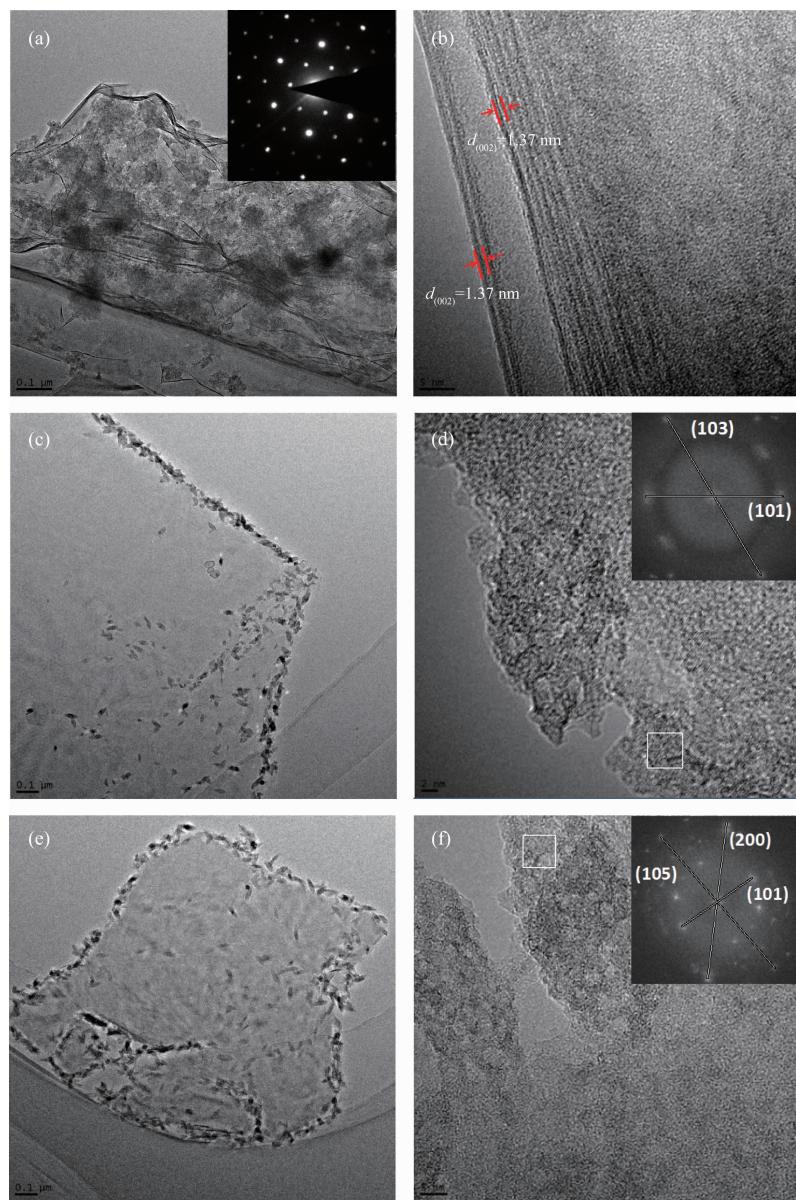
样品中存在明显的 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 的衍射峰，说明低温下 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的氧化程度较低，只有部分 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 被氧化形成了锐钛矿型 TiO_2 。随着氧化温度的升高， $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ 的衍射峰强度逐渐降低，同时锐钛矿型 TiO_2 的衍射峰逐渐增强，说明在高温下 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的氧化程度加深，复合材料中锐钛矿型 TiO_2 的含量增加。

图4为 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}120$ 、 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}140$ 、 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}160$ 和 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2\text{-}180$ 的 SEM 图。当氧化温度为 120 °C 时，样品的表面可以观察到尺寸较小的氧化物颗粒，说明此时样品的氧化程度较浅。随着反应温度的进一步升高， $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的表面逐渐变得粗糙，可以在片层表面和边缘观察到氧化物颗粒逐渐变大且数量增多。说明随着氧化温度的升高， $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的氧化程度逐渐加深，形成了大量的 TiO_2

纳米颗粒,与图 3 中的 XRD 结果相一致。

图 5 为 DL-Ti₃C₂、TiO₂/DL-Ti₃C₂-120 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-160 的 TEM 图。从图 5(a)可以看出,DL-Ti₃C₂ 片较薄,具有褶皱的层状结构,由几层 Ti₃C₂T_x 片堆叠而成,而且在高压电子束作用下,DL-Ti₃C₂ 薄片是稳定的。由于盐酸和氟化锂的混合液比氢氟酸要温和得多,所以制备的 MXene 薄片中纳米尺寸的缺陷很少,这在氢氟酸刻蚀的样品中是常见的^[23]。从选区电子衍射中可以看到明显的六角形衍射花样,表明 DL-Ti₃C₂ 保持了 Ti₃AlC₂ 前驱体的六方晶系结构。图 5(b)测得的 DL-Ti₃C₂ 的晶格间距约为 1.37 nm,对应

Ti₃C₂T_x 的(002)晶面,与图 1(b)的 XRD 测试结果一致。DL-Ti₃C₂ 在 120 ℃ 氧化之后表面有明显的纳米颗粒形成,根据纳米颗粒的 HRTEM 图(图 5(d))采用快速傅里叶变换(FFT)计算纳米颗粒的晶格间距为 0.35 和 0.24 nm,分别对应锐钛矿型 TiO₂ 的(101)和(103)晶面,说明 DL-Ti₃C₂ 在 120 ℃ 氧化后形成了锐钛矿型 TiO₂ 晶体。图 5(e)显示 DL-Ti₃C₂ 在 160 ℃ 氧化后,表面形成的纳米颗粒增多,根据纳米颗粒的 HRTEM 图(图 5(f))采用快速傅里叶变换(FFT)计算纳米颗粒的晶格间距为 0.35、0.19 和 0.17 nm,分别对应锐钛矿型 TiO₂ 的(101)、(200)和(105)晶面。说明



(a, b) DL-Ti₃C₂, (c, d) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120 and (e, f) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160

图 5 样品的 TEM 图

Fig.5 TEM images of the samples

随着氧化温度的升高,DL-Ti₃C₂的氧化程度加深。

2.2 样品的拉曼光谱分析

图6为TiO₂/DL-Ti₃C₂-120和TiO₂/DL-Ti₃C₂-160的拉曼光谱,在144、198、398、513和640 cm⁻¹处的

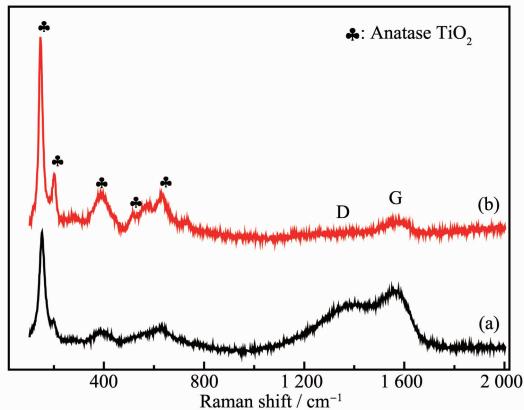


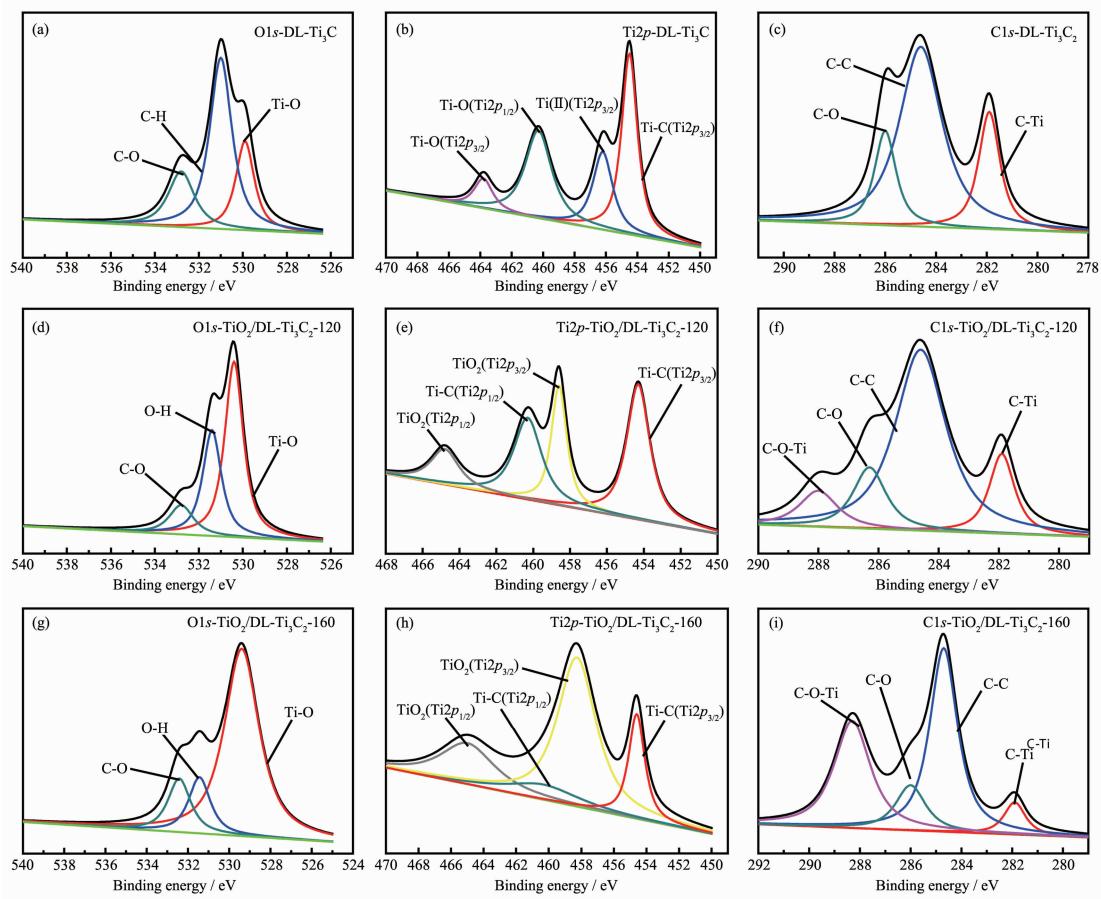
图6 (a) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120 和(b) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160 的拉曼光谱

Fig.6 Raman spectra of (a) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120 and
(b) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160

峰,归属于锐钛矿型TiO₂,而且随着氧化温度的升高,锐钛矿型TiO₂的衍射峰逐渐增强。表明DL-Ti₃C₂在溶剂热过程中氧化生成了锐钛矿型TiO₂,并且随着氧化温度的升高,DL-Ti₃C₂的氧化程度逐渐加深,生成的TiO₂的量逐渐增加。在1350和1590 cm⁻¹处的2个峰分别对应于碳的D峰和G峰,D峰代表的是C原子晶格的缺陷,G峰代表的是C原子sp²杂化的面内伸缩振动。当氧化温度为120 ℃时,两者的强度比值(I_D/I_G)的值约为0.8,说明DL-Ti₃C₂在氧化形成了TiO₂晶体的同时也形成了无定形碳。当氧化温度升高到160 ℃时,无定形碳的含量降低,这是因为氧化温度升高使得无定形碳氧化形成一氧化碳或二氧化碳,与文献报道一致^[24]。

2.3 样品的XPS谱图分析

为了分析DL-Ti₃C₂在氧化前后化学键的变化,对DL-Ti₃C₂及其氧化后的样品进行XPS测试,如图7所示。通过比较氧化前后样品的O1s谱图(图7(a), d, g))发现,刻蚀处理得到的DL-Ti₃C₂表面负载有大



(a, b, c) DL-Ti₃C₂; (d, e, f) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120 and (g, h, i) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160

图7 样品的XPS谱图

Fig.7 XPS spectra of the samples

量的羟基,但是在氧化之后,O-H 键的峰强度减弱,同时 Ti-O 键的峰强度增强。这是因为 DL-Ti₃C₂ 在氧化过程中表面形成了 TiO₂,负载的含氧基团的相对含量减少。从图 7(b,e,h)可以看出,随着氧化温度的升高,Ti-C 键的 Ti2p_{3/2}(454.3 eV)和 Ti2p_{1/2}(460.3 eV)逐渐被 TiO₂ 的 Ti2p_{3/2}(458.9 eV)和 Ti2p_{1/2}(464.7 eV)取代,这说明 DL-Ti₃C₂ 逐渐被氧化形成了 TiO₂,且氧化温度越高,DL-Ti₃C₂ 的氧化程度越深,形成的锐钛矿型 TiO₂ 也越多,但 DL-Ti₃C₂ 并未被完全氧化,DL-Ti₃C₂ 与 TiO₂ 同时存在于复合材料中。从图 7(c,f,i)中可以看出,随着氧化温度的升高,DL-Ti₃C₂ 的 C-Ti(≈ 281.9 eV)键逐渐转化为 C-O-Ti(288.0 eV)键,这与 O1s 和 Ti2p 的谱图结果一致。

2.4 样品的比表面积分析

表 1 列出了不同温度氧化产物的比表面积,可以看出 DL-Ti₃C₂ 的比表面积(S_{BET})为 $45 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$,相比于文献报道^[12]的 ML-Ti₃C₂ 的比表面积增大了几倍。这主要是因为 ML-Ti₃C₂ 在剥离形成 DL-Ti₃C₂ 后,堆积的片层充分暴露出来,使得其比表面积大幅度增加。随着氧化温度的升高,DL-Ti₃C₂ 片层表面氧化形成的 TiO₂ 纳米颗粒增加,比表面积也就越大。当温度达到 180 ℃时,产物的比表面积开始下降,这可能是因为 DL-Ti₃C₂ 氧化程度过深,使得部分 DL-Ti₃C₂ 重新沉积堆叠。

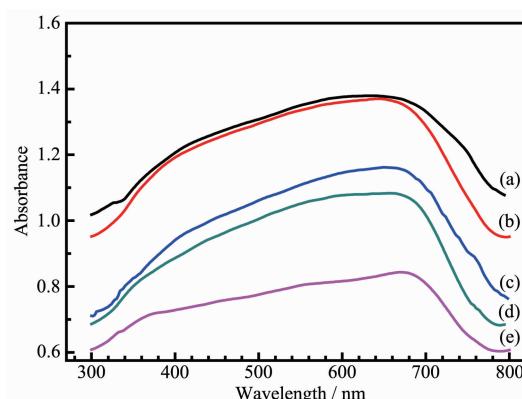
表 1 DL-Ti₃C₂ 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T 的 S_{BET}

Table 1 S_{BET} of DL-Ti₃C₂ and TiO₂/DL-Ti₃C₂-T

Sample	$S_{\text{BET}} / (\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1})$
DL-Ti ₃ C ₂	45
TiO ₂ /DL-Ti ₃ C ₂ -120	48
TiO ₂ /DL-Ti ₃ C ₂ -140	56
TiO ₂ /DL-Ti ₃ C ₂ -160	60
TiO ₂ /DL-Ti ₃ C ₂ -180	54

2.5 样品的紫外-可见漫反射光谱分析

为了研究材料的光吸收性能,对 DL-Ti₃C₂ 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T 进行了紫外-可见漫反射光谱测试。由图 8 可知,DL-Ti₃C₂ 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T 在可见光区域吸收强度均较高,相比于紫外区吸收强度明显增加。随着氧化温度的升高,TiO₂/DL-Ti₃C₂ 对光的吸收能力下降,且吸收边缘略红移。这主要是因为随着氧化温度升高,DL-Ti₃C₂ 的含量逐渐降低,而 TiO₂ 在可见光区域的吸收与 DL-Ti₃C₂ 相比低得多,使得复合材料 TiO₂/DL-Ti₃C₂ 对光的吸收强度下降。光照吸收边缘的红移是由于氧化过程形成 C-O-Ti 键,导致



(a) DL-Ti₃C₂, (b) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120, (c) TiO₂/DL-Ti₃C₂-140,
(d) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160 and (e) TiO₂/DL-Ti₃C₂-180

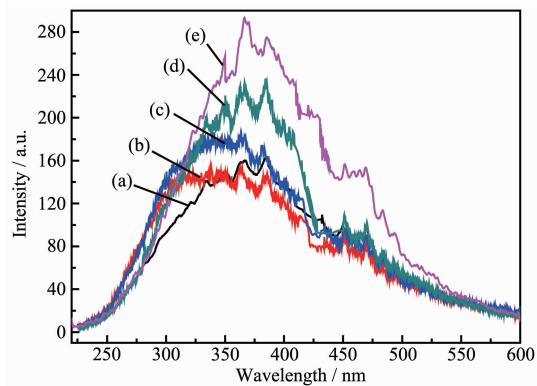
图 8 DL-Ti₃C₂ 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T 的紫外-可见漫反射光谱

Fig.8 UV-Vis diffuse reflection spectra and of DL-Ti₃C₂ and TiO₂/DL-Ti₃C₂-T

TiO₂ 的带隙变窄,与文献报道一致^[11,25-26]。

2.6 样品的荧光光谱分析

荧光光谱主要由半导体中电子与空穴的复合产生,而电子-空穴对的复合率对催化剂的光催化性能有显著的影响。为了研究电子空穴的复合率,对样品进行了荧光光谱分析。图 9 为 DL-Ti₃C₂ 和不同温度氧化制备的 TiO₂/DL-Ti₃C₂ 的荧光光谱。从图中可以看出,TiO₂/DL-Ti₃C₂ 的发射峰位置几乎没有改变,但随着氧化温度的升高,发射峰强度逐渐增加。表明 TiO₂/DL-Ti₃C₂ 的电子-空穴对复合率随着氧化温度的升高逐渐增加。这是因为高导电性的 DL-Ti₃C₂ 材料能够促进 TiO₂ 光生电子空穴的分离,但随着氧化温度的升高,TiO₂/DL-Ti₃C₂ 复合材料中 TiO₂ 的相对



(a) DL-Ti₃C₂, (b) TiO₂/DL-Ti₃C₂-120, (c) TiO₂/DL-Ti₃C₂-140,
(d) TiO₂/DL-Ti₃C₂-160 and (e) TiO₂/DL-Ti₃C₂-180

图 9 DL-Ti₃C₂ 和 TiO₂/DL-Ti₃C₂-T 的荧光光谱
Fig.9 PL spectra of DL-Ti₃C₂ and TiO₂/DL-Ti₃C₂-T

含量增加而 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的相对含量逐渐降低，会使得材料的导电率下降，光生电子和空穴的复合率升高。

2.7 光催化结果分析

图 10 为 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 、 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -T、P25 以及不加催化剂时对罗丹明 B 溶液的脱除率曲线。由图可知，在不加催化剂时，光照下罗丹明 B 溶液基本没有降解。 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 在低温下经过溶剂热氧化处理之后，光催化性能得到了明显提高。随着氧化温度的升高， $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的光催化性能增强，当氧化温度为 160 ℃时，光催化活性达到最高，对罗丹明 B 溶液的降解率达到了 93.1%。 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -160 降解罗丹明 B 溶液的 UV-Vis 光谱如图 11 所示，随着光照时间的延长，罗丹明 B 溶液的吸收光谱强度逐渐下降，表明罗丹明 B 在可见光下发生了降解反应，其浓度逐渐降低。并且罗丹明 B 在降解过程中的最大吸收峰波长

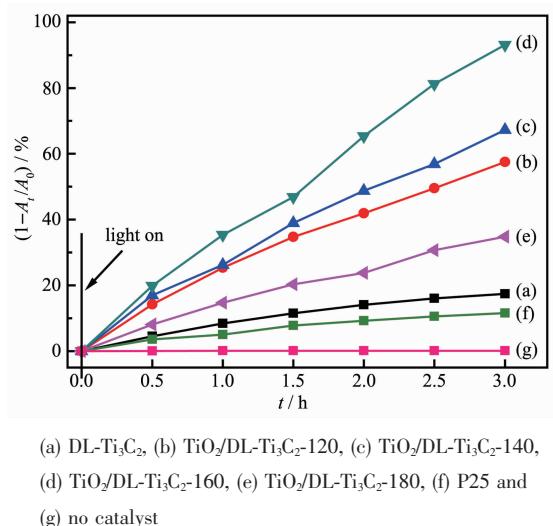


图 10 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 、 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -T、P25 和不加催化剂时对罗丹明 B 溶液的脱除率曲线

Fig.10 Photodegradation rate for rhodamine B on $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$, $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -T, P25 and no catalyst

并未发生改变，始终在 554 nm 左右，表明罗丹明 B 在降解过程中完全矿化，没有生成中间产物。且图 10 表明， $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -160 的光催化性能明显优于 P25。这是因为随着氧化温度的升高，形成的 TiO_2 量增加，光照下产生的电子-空穴对数量增加；而 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 具有优良的电子导电性和较大的比表面积，使得光生电子更容易被转移，抑制了光生电子与空穴的复合，从而提高了复合材料的光催化性能。

$\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 复合材料光催化降解罗丹明 B 溶

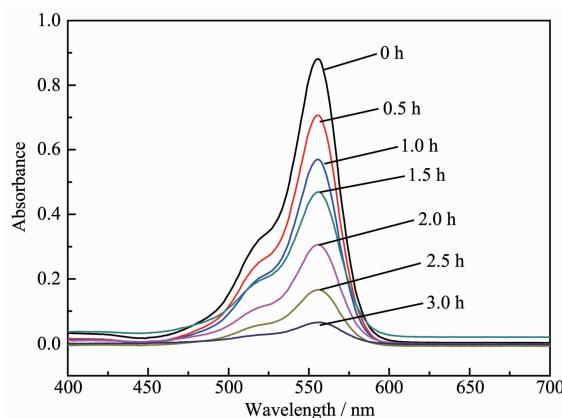


图 11 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -160 降解罗丹明 B 溶液的 UV-Vis 光谱

Fig.11 UV-Vis spectra of rhodamine B solution degraded by $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ -160

液的机理示意图如图 12 所示。 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 在光照后， TiO_2 的价带电子受激发跃迁到导带，产生光生电子-空穴对，而 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的高导电性使得 TiO_2 导带上的光生电子快速传输至 $\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 的表面，促进了光生电子和空穴的分离。之后，光生电子与催化剂表面吸附的氧作用形成超氧负离子($\cdot\text{O}_2^-$)，空穴与催化剂表面的羟基和水分子作用形成羟基自由基($\cdot\text{OH}$)， $\cdot\text{O}_2^-$ 和 $\cdot\text{OH}$ 因其强氧化性能有效降解罗丹明 B 分

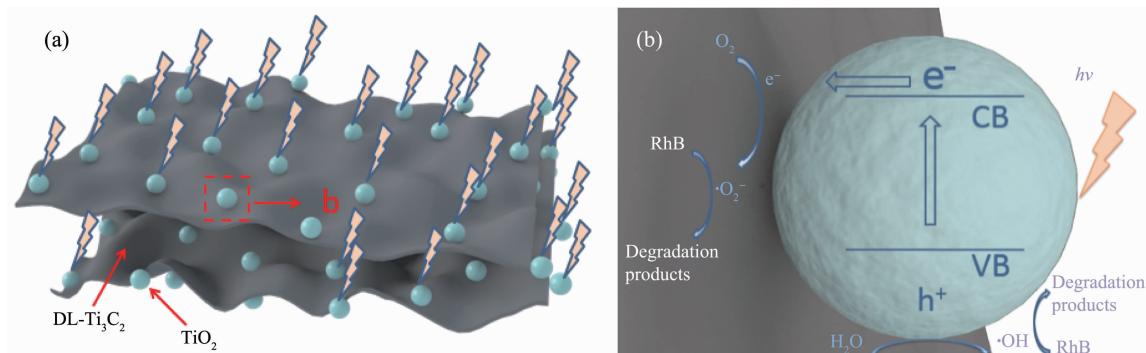


图 12 $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ 复合材料光催化降解罗丹明 B 溶液机理示意图

Fig.12 Mechanism diagram of photocatalytic degradation for rhodamine B solution by $\text{TiO}_2/\text{DL-Ti}_3\text{C}_2$ composite

子。但是随着温度进一步升高,TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料的光催化性能开始下降。这是因为高温下生成TiO₂含量的增加虽然有利于光生电子和空穴的生成,但是DL-Ti₃C₂的氧化程度过深使其电子电导性降低,光生电子与空穴的复合率升高,导致TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料光催化性能反而降低。所以,DL-Ti₃C₂和TiO₂的协同作用对于提高光催化活性至关重要。因此,提高TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料光催化性能的关键是通过控制氧化温度来调节TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料中DL-Ti₃C₂和TiO₂的相对含量。

3 结 论

采用溶剂热法控制氧化DL-Ti₃C₂制备了TiO₂/DL-Ti₃C₂复合光催化剂,并以罗丹明B溶液为目标污染物,在可见光条件下测试TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料的光催化活性。结果表明,在溶剂热反应过程中,DL-Ti₃C₂逐渐氧化形成TiO₂纳米颗粒。随着溶剂热反应温度的升高,生成的TiO₂纳米颗粒增加。TiO₂/DL-Ti₃C₂复合光催化剂对可见光响应且光催化性能明显优于DL-Ti₃C₂,当氧化温度为160℃时,TiO₂/DL-Ti₃C₂-160对于罗丹明B溶液的光催化解率达到最高,约为93.1%。这主要是因为在TiO₂/DL-Ti₃C₂复合材料中,作为光催化剂主体的TiO₂在光照下产生光生电子和空穴,而DL-Ti₃C₂由于其良好的导电性、高的比表面积和丰富的表面含氧基团,促进了污染物在复合材料表面的吸附,加速了TiO₂导带所生成的光生电子的转移,提高了光生电子-空穴的分离效率。此外,DL-Ti₃C₂原位氧化生成TiO₂的同时,形成C-O-Ti键,使TiO₂的带隙变窄,有利于提高TiO₂对可见光的吸收和利用。因此,可以通过控制氧化温度来调节Ti₃C₂/DL-TiO₂复合材料中DL-Ti₃C₂和TiO₂的相对含量,使二者协同作用以提高TiO₂/DL-Ti₃C₂复合光催化剂的性能。

参考文献:

- [1] Zhang J L, Wu Y M, Xing M Y, et al. *Energy Environ. Sci.*, **2010**,*3*(6):715-726
- [2] Ouyang J L, Chang M L, Li X J, et al. *J. Mater. Sci.*, **2012**,*47*(9):4187-4193
- [3] Waldner G, Pourmodjib M, Bauer R, et al. *Chemosphere*, **2003**,*50*(8):989-998
- [4] Daghrir R, Drogui P, Robert D. *J. Photochem. Photobiol. A*, **2012**,*238*:41-52
- [5] Daghrir R, Drogui P, Robert D. *Ind. Eng. Chem. Res.*, **2013**,*52*(10):3581-3599
- [6] Ren W J, Ai Z H, Jia F L, et al. *Appl. Catal. B*, **2007**,*69*(3):138-144
- [7] Suwanchawalit C, Wongnawa S, Sriprang P, et al. *Ceram. Int.*, **2012**,*38*(6):5201-5207
- [8] Kitano S, Murakami N, Ohno T, et al. *J. Phys. Chem. C*, **2013**,*117*(21):11008-11016
- [9] Fang J, Wang F, Qian K, et al. *J. Phys. Chem. C*, **2008**,*112*(46):18150-18156
- [10] Palanisamy B, Babu C M, Sundaravel B, et al. *J. Hazard. Mater.*, **2013**,*252-253*:233-242
- [11] Fan W Q, Lai Q H, Zhang Q H, et al. *J. Phys. Chem. C*, **2011**,*115*(21):10694-10701
- [12] LONG Mei(龙梅), CONG Ye(丛野), LI Xuan-Ke(李轩科), et al. *Acta Phys.-Chim. Sin.*(物理化学学报), **2013**,*29*(29):1344-1350
- [13] Berdiyorov G R, Mahmoud K A. *Appl. Surf. Sci.*, **2017**,*416*:725-730
- [14] Zhang T, Pan L M, Tang H, et al. *J. Alloys Compd.*, **2016**,*695*:818-826
- [15] Mashtalar O, Naguib M, Mochalin V N, et al. *Nat. Commun.*, **2013**,*4*(1):1716
- [16] Lv G X, Wang J, Shi Z Q, et al. *Mater. Lett.*, **2018**,*219*:45-50
- [17] Sun Y L, Jin D, Sun Y, et al. *J. Mater. Chem. A*, **2018**,*6*(19):9124-9131
- [18] Peng C, Yang X F, Li Y H, et al. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **2016**,*8*(9):6051-6060
- [19] Zhang C F, Kim S J, Ghidiu M, et al. *Adv. Funct. Mater.*, **2016**,*26*(23):4143-4151
- [20] Lotfi R, Naguib M, Yilmaz D E, et al. *J. Mater. Chem. A*, **2018**,*6*(26):12733-12743
- [21] Naguib M, Mashtalar O, Lukatskaya M R, et al. *Chem. Commun.*, **2014**,*50*(56):7420-7423
- [22] Liu Y, Wang W, Ying Y L, et al. *Dalton Trans.*, **2015**,*44*(16):7123-7126
- [23] Mashtalar O, Naguib M, Dyatkin B, et al. *Mater. Chem. Phys.*, **2013**,*139*(1):147-152
- [24] Yuan W Y, Cheng L F, Zhang Y N, et al. *Adv. Mater. Interfaces*, **2017**,*4*(20):1700577-1700587
- [25] Xiang Q J, Yu J G. *J. Phys. Chem. Lett.*, **2013**,*4*(5):753-759
- [26] Zhang Y H, Tang Z R, Fu X Z, et al. *ACS Nano*, **2011**,*5*(9):7426-7435